

Спосіб отримання напівпровідникових штучних підкладок включає отримання на поверхні напівпровідникової підкладки спочатку проміжного напівпровідникового шару, в якому відбувається релаксація пружних напружень невідповідності, а потім вирощування на ньому малодфектного напівпровідникового шару, відмінного за параметром ґратки і хімічного складу від напівпровідникової підкладки, в одному технологічному процесі. Проміжний напівпровідниковий шар отримують з того самого матеріалу, що і малодфектний напівпровідниковий шар, та він є комірковим шаром.